

碳化硅晶体生长炉

Silicon Carbide Crystal Growth Furnace

TDL85P



性能指标

- 碳化硅晶体直径不小于 6 英寸
- 生长腔体真空度极限真空优于 5.0×10^{-5} Pa
- 生长腔体保压 12 小时后真空度 ≤ 5 Pa
- 生长腔压力控制范围 100—90000 Pa
- 最高加热温度不小于 2600 °C
- 共 6 路特气（包括 Ar、N₂、H₂ 三种气体）

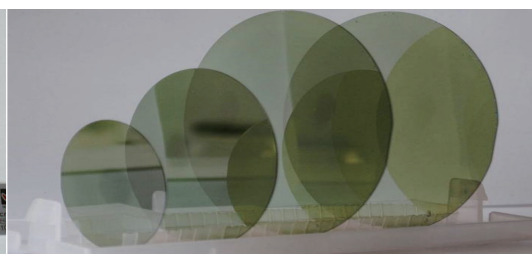
主要应用

用于以 SiC 为代表的晶体材料制备

代表性应用成果



碳化硅晶体



碳化硅晶片

| | |
|--------|---|
| 主要用户单位 | 中国科学院上海硅酸盐研究所、中国科学院物理研究所、北京天科合达半导体股份有限公司、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、北京世纪金光半导体有限公司等 |
| 研制单位 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 |
| 联系方式 | 方老师 024-23826855、23826899、23826827、23826820 |